

ORGANIC ELECTRO-LUMINESCENCE DEVICE AND FABRICATING METHOD THEREOF

Publication number: KR20040021909

Publication date: 2004-03-11

Inventor: KIM CHANG NAM

Applicant: LG ELECTRONICS INC

Classification:

- international: H01L51/50; H01L51/52; H05B33/10; H05B33/22; H05B33/26; H01L27/32; H01L51/50; H05B33/10; H05B33/22; H05B33/26; H01L27/28. (IPC1-7): H05B33/26

- European: H01L51/52B2; H01L51/52B4; H05B33/10; H05B33/26

Application number: KR20020053562 20020905

Priority number(s): KR20020053562 20020905

Also published as:

EP1399003 (A1)
US7211947 (B2)
US2007138944 (A1)
US2004160176 (A1)
JP2004103582 (A)

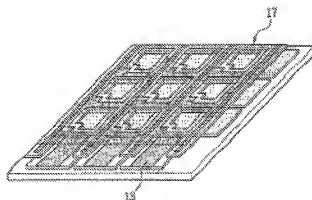
more >>

Report a data error here

Abstract of KR20040021909

PURPOSE: An organic electro-luminescent device and a fabricating method thereof are provided to reduce a resistance of a cathode by forming a contact between an auxiliary electrode and the cathode on a predetermined region without organic materials. **CONSTITUTION:** An organic electro-luminescent device includes an auxiliary electrode for cathode. The auxiliary electrode for cathode is formed on an insulating layer (12). The auxiliary electrode for cathode is formed with one of Cr, Al, Au, W, Cu, Ni, and Ag. A method for fabricating the organic electro-luminescent device includes a process for forming the auxiliary electrode for cathode on the insulating layer (12), a process for forming an organic layer by covering a shadow mask on the auxiliary electrode, and a contact process between the auxiliary electrode for cathode and a cathode.

FIG. 3G



Data supplied from the [esp@cenet](http://www.esp@cenet.com) database - Worldwide

(19) 中国音乐家(张)

(12) 공개특허공보(A)

1000

NOB 36/25

(11) 공제번호

(43) 품계일자

10-204-00219B

2014년 1월

(21) 출원번호	10-2602-D053582
(22) 출원일자	2012년 09월 05일
(71) 출원인	웹지전자 주식회사 서울특별시 영등포구 여의도동 20번지
(72) 발명자	김형남
(74) 대리인	서울특별시 중랑구 공평동 289-24 김윤민, 김현진

2017年12月22日

(54) 유기 EL 소자 및 그 제조 방법

22

발광층 유기 EL(electroluminescence)소자 및 박막 디스플레이(fat panel display) 발광층 재료의 특성에 따라 여러 가지 구조를 사용하는 유기 EL 소자에 관한 것이다. 이와 같은 발광층에 유기 EL 소자는 유기 발광층을 형성하는 유기 EL에 있어서, 발광층 위에 형성되는 캐소드층 또는 전극층에 관한 것이다.

345

555

4242

924

244

509 202 AD

도 1의 중량의 불균형 양기 현 표시 소자를 도시한 도면

도 2는 충청의 철도요망지역과 도시화도면

도 36과 내지 도 38은 본 발명에 따른 유가 및 소자를 나타낸 사시도

도 36b 바지 도 36b는 본 발명의 다른 실시예로 유가인 소자를 다수의 물면도

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 5TH AVENUE
NEW YORK 17, N.Y.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

第五 万有引力 第三十三讲 万有引力

도전의 조력 본래의 목적 본회의 설명

10 : 7/24

1994

三、總之 國以民為本

11-2 : 銅노드 수직형 열전

12 : 2094

10 : 345

12-1 : 利子に基き利息

13-2 : 제2차 경제개발 5개년계획을 위한 기본

14 : 25

15-1 : 섹도우 마스크의 종류

199-130-134 200-130-200 201-130-201

2009 2008

앞에서 속하는 거수분야 및 그 분야의 종사자들

로 발광은 유기 EL(electroluminescence)소자 필한 디스플레이(first panel display) 필발의 애노드용 보조전극과 이나리 캐소드용 보조전극을 사용하는 유기 EL 소자에 관한 것이다.

일반적으로 표시는 매트릭스 방식의 유기 EL 디스플레이 소자를 만드는 데 있어서, 하나의 캐소드 라인에 모든 데이터(애노드)의 전류가 온(on)되며 전류가 흐르기 때문에 캐소드 라인의 공통은 소자의 효율(소비 전력)에 많은 영향을 미친다.

보통 캐소드는 시를 사용하게 되는데, 유기물을 형성한 후 그 위에 형성하게 되므로 캐소드를 보조전극을 일단 애노드 공정으로 형성하기 어렵다.

도 1은 종래의 플랫퍼 유기 EL 표시 소자를 도시한 도면이고, 도 2는 종래의 애노드 마스크를 도시한 도면이다.

도 1 내지 도 3에 도시된 바와 같이, 먼저 글래스 기판(1)상에 양극을 인가하기 위한 투명 전극의 ITO 스트림(2)을 형성한다.

그리고 그 상부에 애노드 마스크(4)를 적용하여 R, G, B 픽셀(3-1, 3-2, 3-3)을 각각 형성한다.

여와 같이 사용되는 유기 EL 소자는 캐소드를 보조전극이 없는 구조로서 캐소드의 저항이 높아 소자의 소비전력을 높이는 단점이 있다.

그리고, 통상적으로 캐소드는 시를 사용하게 되는데, 유기물을 형성한 후 그 위에 형성하게 되므로 캐소드용 보조전극을 일단 애노드 공정으로 형성하기 어려운 단점이 있다.

발광에 아무교자 하는 기판의 구조

따라서, 본 발명의 목적은 이상에서 언급한 종래 기술의 문제점을 감안하여 안출한 것으로서, 발광에 의해 캐소드를 보조 전극을 미리 형성한 후 유기물 형성시 이 보조전극의 일부에 증착되지 않게 애노드 마스크를 가려 증착한 후 캐소드를 형성하여 유기물이 증착되지 않은 부분에서 보조전극 전체가게 함으로써 캐소드의 저항을 줄이는 유기 EL 소자를 제공하기 위한 것이다.

본 발명의 구성 및 작용

이상과 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징에 따르면, 유기 발광층을 형성하는 유기 요에 있어서, 발광에 의해 형성되는 캐소드용 보조전극을 포함하여 구성된다.

바람직하게, 상기 캐소드용 보조전극의 물질은 Cr, Al, Au, W, Cu, Ni, Ag 중 하나이다.

이상과 같은 다른 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 특징에 따르면, 유기 발광층을 형성하는 유기 EL 소자의 제조 공정은 있어서, 절연에 의해 캐소드를 보조전극을 형성하는 단계와, 상기 보조전극을 애노드 마스크로 가려 유기막을 증착하는 단계와, 상기 유기막이 형성되지 않은 부분에서 보조전극을 증착하는 단계를 포함하여 이루어진다.

이하 본 발명의 바람직한 일 실시 예에 따른 구성 및 작용을 첨부된 도면을 참조하여 설명한다.

도 3a 내지 도 3g는 본 발명에 따른 유기 EL 소자를 나타내는 사시도이고 도 3b 내지 도 3f는 본 발명에 따른 유기 EL 소자를 나타내는 평면도이다.

먼저, 도 3a와 도 3b와 같이 글래스 기판(10) 위에 ITO 또는 투명전극인 애노드(11)를 형성한다.

이때, 캐소드(13)를 패배기 위한 ITO 스트림 패스(11-2)도 동시에 형성한다.

그리고 도 3b 내지 도 3b와 같이 애노드(11) 저항을 줄이기 위해 보조전극(11-1)을 사용될 수도 있다.

이 보조전극(11-1)으로 쓰이는 물질은 저항이 작은 메탈(metal)을 쓰는데, 예를 들면 Cr, Al, Cu, W, Au, Ni, Ag 등이 쓰인다.

이어서 도 3c 내지 도 3c와 같이 애노드(11) 위에 절연막(12)을 형성한다.

이때, 절연막(12)으로 쓰이는 물질은 무기물, 유기물이나 상관없이 절연체이면 된다.

그리고, 절연막(12) 위에 도 3d와 도 3d와 같이 캐소드 보조전극(13-1)을 형성한다.

이 보조전극(13-1)은 절연막(12) 위 어느곳에 형성해도 상관없으며, 캐소드 라인에 할 부분이라는 표시된 바와 같이 나누어져 있어야 한다.

또한, 나뉘면 캐소드(3)와 전력을 위한 부분(13-2)이 형성된다.

여기서 사용되는 보조전극(13-1)의 재료는 애노드 보조전극(11-1) 재료와 마찬가지로 저항이 작은 메탈(metal)을 사용하면 된다.

그리고 도 3e와 도 3e와 같이 캐소드 스트림 사이의 절연을 위해 국벽(electrical insulative strip)(14)을 형성한다.

한편, 도 3f와 같이 애노드 마스크를 만든다.

이때, 캐소드 보조전극(13-1)의 전력을 위한 애노드 마스크 홀층부(15-1)를 만들어 캐소드(13)와 캐소드용 보조전극(13-1)과의 전력부분에 유기물이 증착되지 않게 3f와 도 3f와 같이 유기물 R, G, B를 각각 증착한다.

또한, 홀(hole)을 한터면에 형성한 애노드 마스크(15)를 사용하면 된다.

그 다음, 불활성 섀도우 마스크를 이용하며 도 3a와 도 3b와 같이 캐소드(13)를 형성한다.

상기 캐소드(13) 물질로는 Mg-Ag 합금, Al 또는 기타 도전성 물질을 이용한다.

이때, 도 3a의 단면 a와 b와 같이 캐소드(13)와 캐소드 보조전극(13-1)이 권박되게 되는데, 이를 도 4와 도 5에 도시하였다.

이어서, 캐소드(13)를 형성한 후, 미도시 하였지만, 보조막층인 산소층(4)을, 수분층(5)을, 방출층(6)을 형성시키고, 그 위에 인접층(미도시)을 실시한다.

발명의 효과

미상의 설명에서와 같이 본 발명은 유기 EL 소자를 만드는 데 있어서, 캐소드(13)를 형성하기 위해 절연막 위에 캐소드용 보조전극을 미리 형성한 후 유기막을 형성할 때 이 보조전극의 일부분에 용해되지 않게 섀도우 마스크로 가려 정확한 후, 캐소드를 형성하여 유기물이 용해되지 않은 부분에서 보조전극과 권박되게 함으로써 캐소드의 수명을 늘릴 수 있어 소자의 효율을 증대시키는 효과가 있다.

미상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술 사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다.

따라서, 본 발명의 기술적 범위는 실시예에 기재된 내용으로 한정하는 것이 아니라 특허 청구 범위에 의해서 정해져야 한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1

유기 발광층을 형성하는 유기 EL에 있어서,

절연막 위에 형성되는 캐소드를 보조전극을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 유기 EL 소자.

청구항 2

제 1항에 있어서,

상기 캐소드를 보조전극의 물질은 Cr, Al, Au, W, Cu, Ni, Ag 중 하나만 것을 특징으로 하는 유기 EL 소자.

청구항 3

유기 발광층을 형성하는 유기 EL 소자의 제조 방법에 있어서,

절연막 위에 캐소드용 보조전극을 형성하는 단계와

상기 보조전극을 섀도우 마스크로 가려 유기막을 형성하는 단계와

상기 유기막이 형성되지 않은 부분에서 보조전극을 권박하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 EL 소자 제조 방법.

도면

도면 1

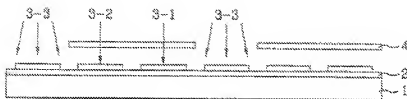


圖 10

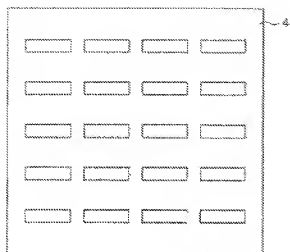


圖 11

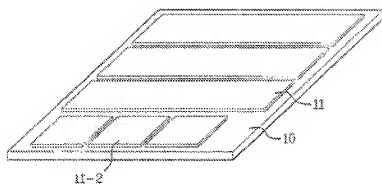


Fig. 3a

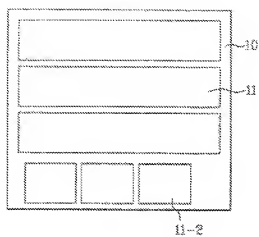


Fig. 3b

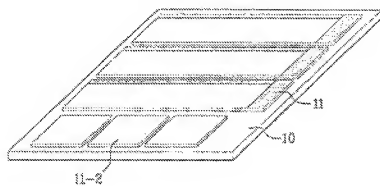


図10

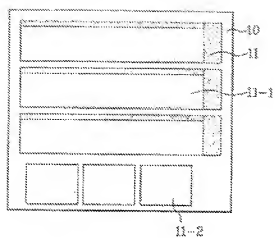


図11

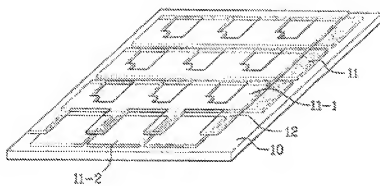


図36

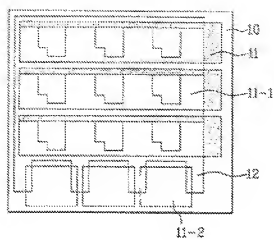


図36

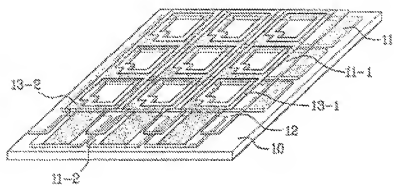


図 13(a)

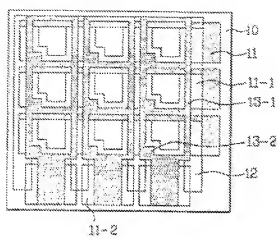


図 13(b)

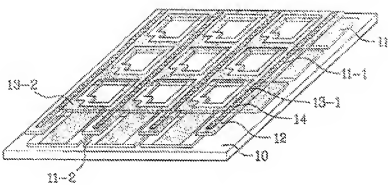
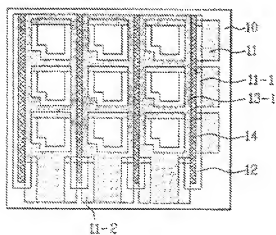
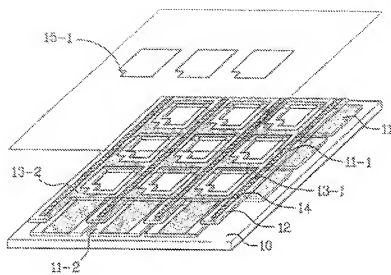


図 13(c)



5085f



5000A

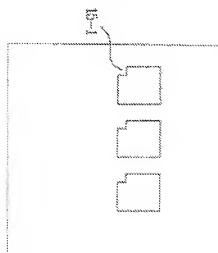
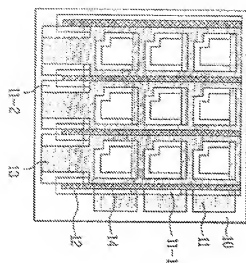


Fig. 3a

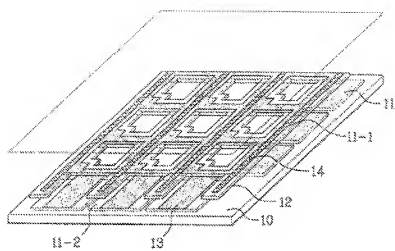


Fig. 3b

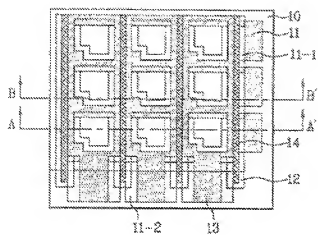


Fig. 3c



505



508

